

2SC5287

シリコンNPN三重拡散プレーナ型トランジスタ (高耐压スイッチングトランジスタ)

用途: スイッチングレギュレータ、一般用

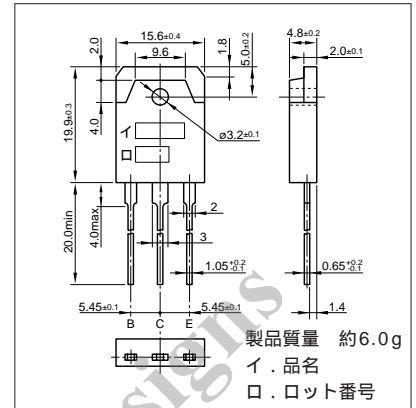
絶対最大定格 (Ta = 25)

記号	規格値	単位
V _{CB0}	900	V
V _{CE0}	550	V
V _{EB0}	7	V
I _C	5(パルス10)	A
I _B	2.5	A
P _C	80(Tc = 25)	W
T _j	150	
T _{stg}	- 55 ~ + 150	

電気的特性 (Ta = 25)

記号	試験条件	規格値	単位
I _{CB0}	V _{CB} = 800V	100max	μA
I _{EB0}	V _{EB} = 7V	100max	μA
V(BR)CEO	I _C = 10mA	550min	V
h _{FE}	V _{CE} = 4V, I _C = 1.8A	10 ~ 25	
V _{CE(sat)}	I _C = 1.8A, I _B = 0.36A	0.5max	V
V _{BE(sat)}	I _C = 1.8A, I _B = 0.36A	1.2max	V
f _r	V _{CE} = 12V, I _E = - 0.35A	6typ	MHz
COB	V _{CB} = 10V, f = 1MHz	50typ	pF

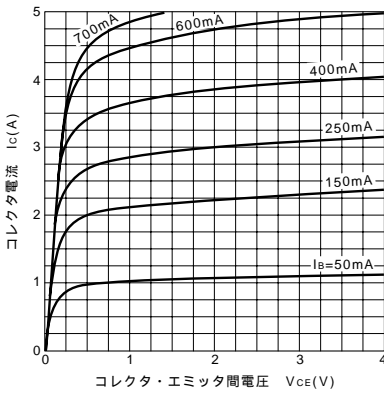
外形図 MT-100(T03P)



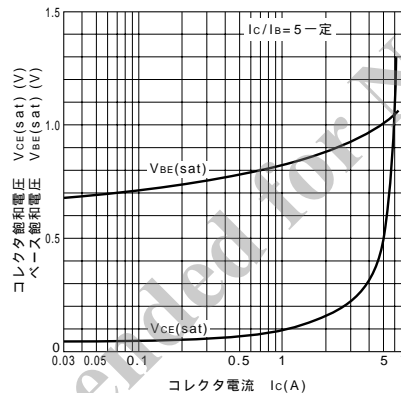
代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	V _{BB1} (V)	V _{BB2} (V)	I _{B1} (A)	I _{B2} (A)	t _{on} (μs)	t _{stg} (μs)	t _f (μs)
250	139	1.8	10	-5	0.27	-0.9	0.7max	4.0max	0.5max

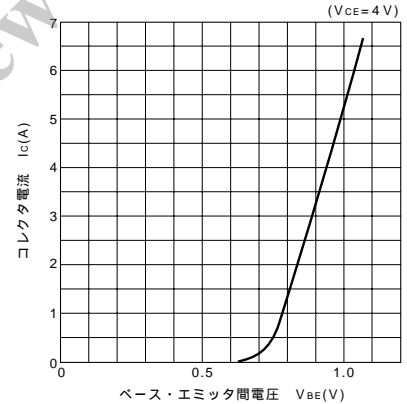
I_C-V_{CE}特性 (代表例)



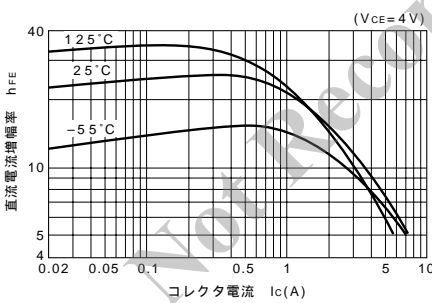
V_{CE(sat)}, V_{BE(sat)}-I_C特性(代表例)



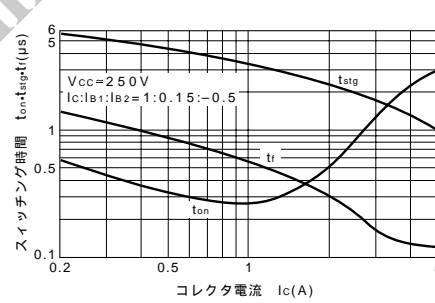
I_C-V_{BE}温度特性 (代表例)



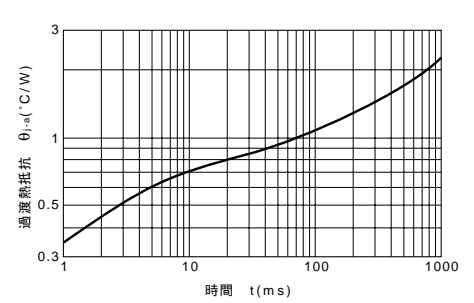
h_{FE}-I_C温度特性 (代表例)



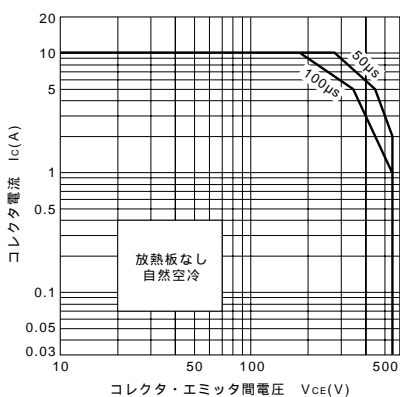
t_{on}•t_{stg}•t_r-I_C特性 (代表例)



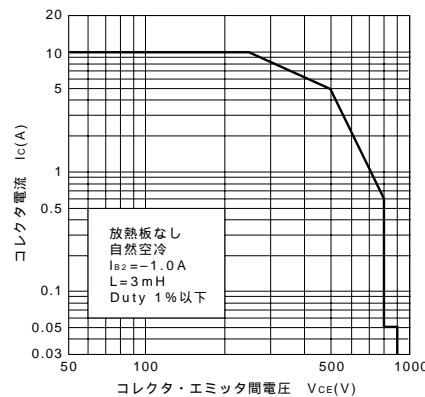
θ_{j-a}-t特性



ASO曲線 (単発パルス)



逆バイアスASO曲線



P_C-T_a定格

